1 目的

次のことを数値的に検証することを目的とする.

- 1. フェルミエネルギーがバンドギャップの中にある時に絶縁体(半導体)となること,及び,ギャップの 外にある時に導体になること.
- 2. バンドギャップの中の電子状態密度がゼロ(外がノンゼロ)になること.
- 3. 一次元物質の場合、電子状態密度が、エネルギー分散の傾きに反比例すること.

2 実験概要

グラフェンナノリボン(GNR)の電子状態を、強束縛(タイトバインディング)近似法に基づいて求める。 その際、炭素原子の $2p_z$ 軌道にのみを扱い、他の軌道は無視する。さらに、エネルギー分散、電子状態密度 (DOS), 電気伝導度(コンダクタンス), 及び電流分布を求める. 以上の全てを数値計算で求める.

3 理論

3.1 グラフェンナノリボン (GNR)

グラフェンとは、炭素原子が蜂の巣状に並んだ二次元シート状物質のこと. GNRとは、その一部を切り取って 出来る一次元ワイヤー状物質のこと、GNRの電子状態は、グラフェンの切り取り方に依存して変化するため、 電気伝導特性も切り取り方に依存する.

ここでは、アームチェア型のGNRを使用する、アームチェア型の GNR とは、 21^{*1} のように、 21^{*1} のように、21面の両端(エッジ)がアームチェアの形をしている GNR のことである。アームチェア型GNRは、ワイヤー 幅に依存して、絶縁体(半導体)になったり、導体になったりすることが知られている。

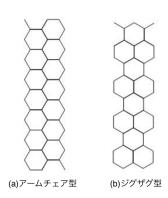


図1 グラフェン・ナノリボンの構造:アームチェアとジグザグ

3.2 GNRの電子状態

GNRは二次元シート状のグラフェンを切り取って出来る一次元ワイヤーである。エネルギー分散E(k)は、次 のようになる.

^{*1} カーボンナノチューブの構造,http://www.center.shizuoka-c.ed.jp/,2019-4-11閲覧

$$E(k) = \pm \sqrt{1 + 4\cos\left(\frac{n}{N+1}\pi\right)\cos\left(\frac{k}{2}\right) + 4\cos^2\left(\frac{n}{N+1}\pi\right)}$$
(3.1)

ただし、Nは、ワイヤーに平行で、なおかつ炭素原子上を通る直線の本数である。すなわち、<math>ワイヤー幅はNに比例する.

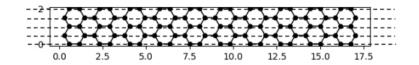


図2 グラフェン・ナノリボンの構造:アームチェアとジグザグ

N=5に対するE(k)を図示すると、図3が得られる.これは、グラフェンのエネルギーのグラフにおいて、縦 軸(//E)に平行で等間隔な平面の集合によってE(k)を切断したときに、それらの断面上に生じる曲線の集合で ある. その様子を図4に示す.

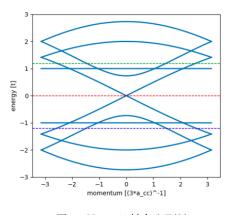


図3 N = 5に対するE(k)

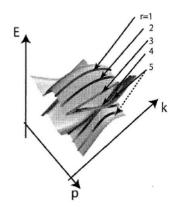


図4 グラフェンとGNRのエネルギーバンドの関係

もし切断平面集合の中に、K点やK'点を通る平面が含まれている場合は、バンドギャップが形成されない。 一方,集合内に,K点やK'点を通る平面が存在しない場合は,バンドギャップが形成される.

実験方法

図5のような4種類の太さのGNRを作成し、それらのエネルギー分散、電子状態密度(DOS)、電気伝導度 (コンダクタンス), および電流分布を求める.

計算には、タイトバインディング計算用のpythonライブラリ「KWANT」を使用して記述されたソースコ ードを使用する. ソースコード, および計算環境は, 担当教員によって, あらかじめ用意されている.

図5 GNRの結晶構造

考察の方針 5

4種類のGNRのエネルギー分散,電子状態密度 (DOS),電気伝導度 (コンダクタンス),および電流分布 を比較し,以下の検証を中心に考察する.

- 1. フェルミエネルギーがバンドギャップの中にある時に絶縁体(半導体)となること,及び、ギャップの 外にある時に導体になること.
- 2. バンドギャップの中の電子状態密度がゼロ(外がノンゼロ)になること.
- 3. 一次元物質の場合,電子状態密度が,エネルギー分散の傾きに反比例すること.

さらに、エネルギー分散の傾きがゼロのところで DOS が発散している理由や、コンダクタンスがステップ 構造をとる理由について考察して正しい結論を導く.

6 実験結果

6.1 エネルギー分散

4種類(w=2.0, w=2.5, w=3.0, w=3.5)のGNRのエネルギー分散をそれぞれ図6から図9に示す.

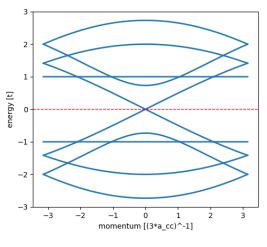


図6 w=2.0のエネルギー分散

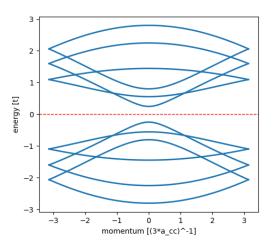


図7 w=2.5のエネルギー分散

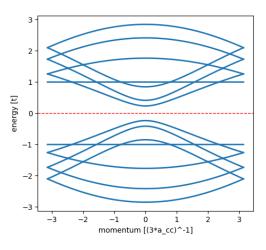


図8 w=3.0のエネルギー分散

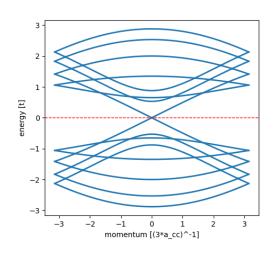


図9 w=3.5のエネルギー分散

6.2 電子状態密度 (DOS)

4種類(w=2.0, w=2.5, w=3.0, w=3.5)の電子状態密度(DOS)をそれぞれ図10から図13に示す.

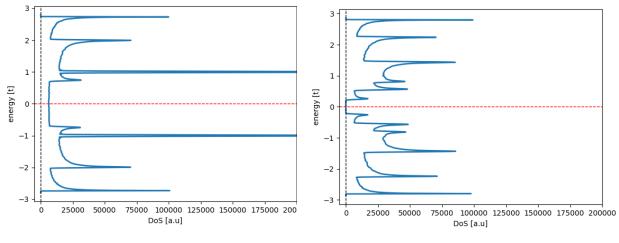


図10 w=2.0の電子状態密度

図11 w=2.5の電子状態密度

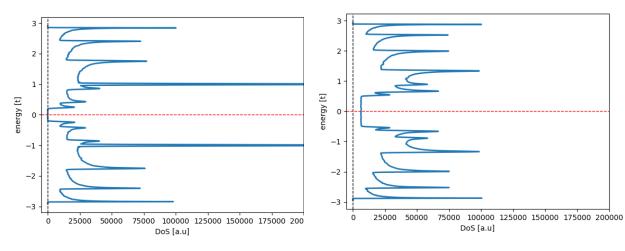


図12 w=3.0の電子状態密度

図13 w=3.5の電子状態密度

4.0

conductance [2*e^2/h]

図17 w=3.5のコンダクタンス

6.3 コンダクタンス

-3

0.0

0.5

1.0

図16 w=3.0のコンダクタンス

1.5

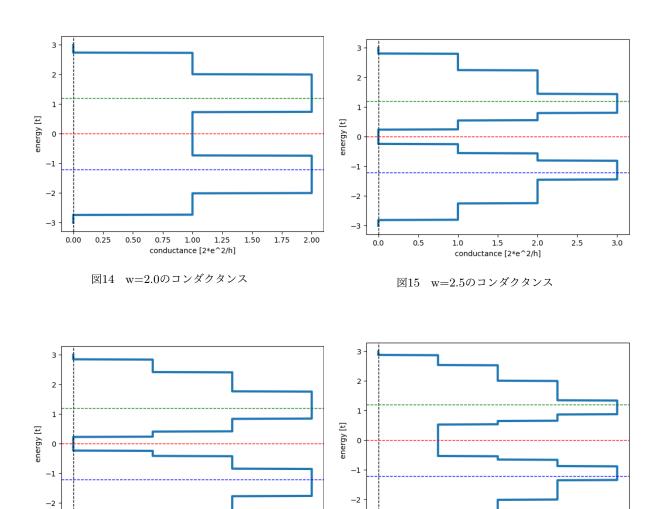
conductance [2*e^2/h]

2.0

2.5

3.0

4種類(w=2.0, w=2.5, w=3.0, w=3.5)のコンダクタンスをそれぞれ図14から図17に示す.



6.4 電流分布

w=2.0のGNRでエネルギーが-1.2, 1.2, 0における(図14での青、緑、赤に対応する)電流分布をそれぞれ 図18, 図19, 図20に示す.

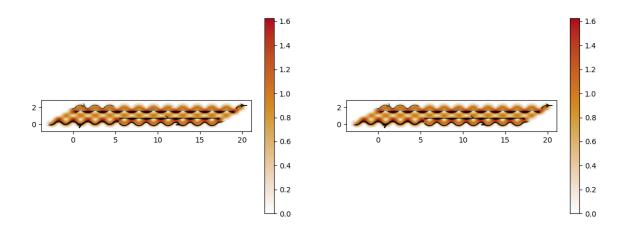


図18 エネルギーが-1.2での電流分布

図19 エネルギーが1.2での電流分布

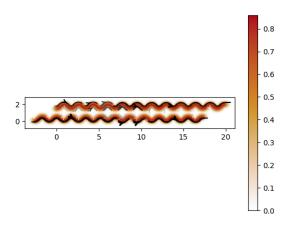


図20 エネルギーが0での電流分布

7 考察

図6,図9のw=2.0,w=3.5でのエネルギー分散を見るとギャップが無く,図7,図8のw=2.5,w=3.0のエネルギー分散を見ると,ギャップがあることが確認できる.この時,w=2.0,w=3.5のコンダクタンス(図14,図17)を確認すると0でない値を取っていることがわかる.一方で,w=2.5,w=3.0のコンダクタンス(図15,図16)はゼロを取っており,不導体の性質を示していることが確認できる.

以上のことから,フェルミエネルギーがバンドギャップの中にある時に不導体となり,ギャップの外にある時に導体になることが確認できた.

w=2.0,w=3.5の電子状態密度(DOS)(図10,図13)はエネルギー0の際にノンゼロであった.一方,w=2.5,w=3.0のDOS(図11,図12)はエネルギー0の際に0となっていた.前述のように,図6~図9のグラフから,w=2.0,w=3.5ではエネルギー0の際にギャップが存在せず,w=2.5,w=3.0の際にはギャップが確認されている.

以上のことから、バンドギャップの内ではDOSはゼロとなることがわかる.

エネルギー分散のグラフ(図6~図9)とDOSのグラフ(図10~図13)を比較すると、エネルギー分散の傾きが大きいポイントでは、DOSの値は小さくなっていることがわかる.加えて、エネルギー分散の傾きが0の点(図6のエネルギー1付近)ではDOSは発散している(図10のエネルギー1付近).

このことから、エネルギー分散の傾きとDOSは反比例関係にあることが確認できる.

今回のようなk空間で状態が等間隔に存在しているとき,空間でのDOS,すなわち単位波数当たりの状態密度は一定値 $1/(\Delta k)$ である.

分散関係E(k)が単調であれば,E空間でのDOSは

$$\rho(E)dE = \frac{dk}{\Delta k} \tag{7.1}$$

より,

$$\rho(E) = \frac{1}{\Lambda k} \frac{\partial k}{\partial E} \tag{7.2}$$

である.

したがって,上のように $\frac{dE}{dk}=0$ となる点においては,DOS状態密度は発散する.

また、w2.5のエネルギー分散のグラフ(図7)を確認すると、エネルギーが-3から-2.8程度の間には交点は存在せず、-2.8から-2程度の間には2点、-1付近では6点の交点が存在している。一方で、w2.5のコンダクタンスのグラフ(図15)を見ると、エネルギーが-3から-2.8程度の間のコンダクタンスは1となっていた。-2付近は2、-1付近では3というコンダクタンスの値が出ていた。

以上のことから,コンダクタンスの値は,エネルギー分散のグラフの交点と対応関係にあることがわかる.